

特点

- 低集电极 - 发射极饱和电压
- 高集电极电流能力
- 高英法效率，降低了发热
- 减少所需的印刷电路板的面积
- 成本效益的替代中等功率晶体管 BCP55和BCX55。

CESAT
c 我 OM

应用

- 主要应用领域：
 - 汽车42 V电源
 - 电信基础设施
 - 工业。
- 电源管理：
 - 直流 - 直流转换
 - 供电线路开关。
- 外围设备驱动程序
 - 驾驶员在低电源电压应用（如灯和LED）
 - 感性负载驱动器（例如继电器，蜂鸣器和电机）。

描述

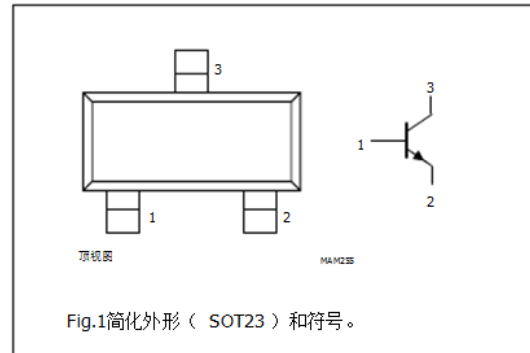
NPN低V CESAT 晶体管在SOT23塑料包装。
PNP补充： PBSS5160T。

快速参考数据

符号	参数	马克斯。	单位
$V_{CE(sat)}$	集电极 - 发射极电压	60	V
I_C	集电极电流 (DC)	1	A
I_{CM}	峰值集电极电流	2	A
R_{CESAT}	导通电阻的等效	250	mΩ

钉扎

针	描述
1	BASE
2	辐射源
3	集热器



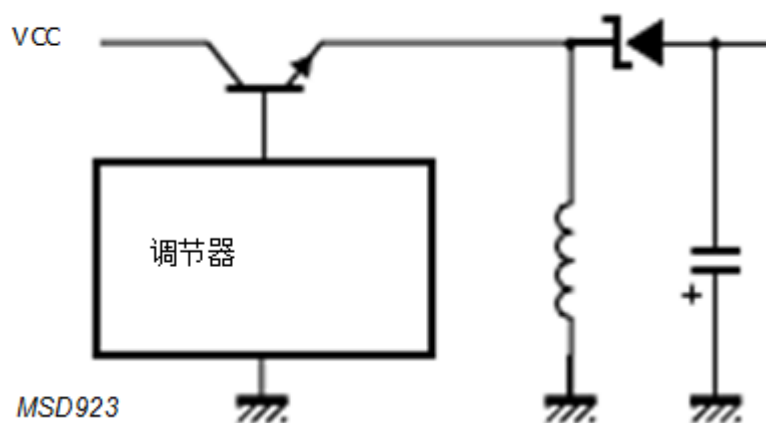
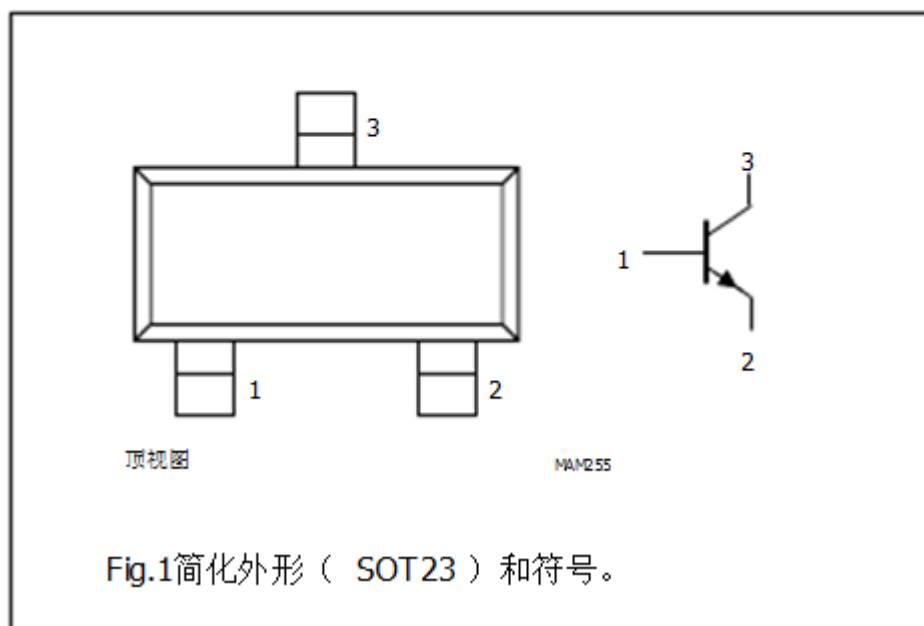
极限值

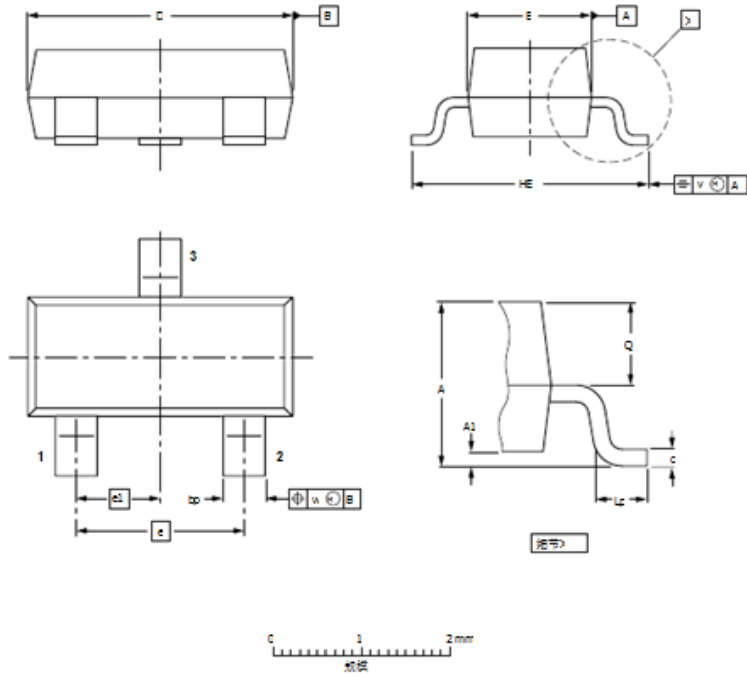
按照绝对最大额定值系统 (IEC 60134) 。

符号	参数	条件	分钟。	马克斯。	单位
V_{CEC}	集电极 - 基极电压	发射极开路	-	80	V
$V_{CE(sat)}$	集电极 - 发射极电压	开基	-	60	V
V_{EB-C}	发射极 - 基极电压	集电极开路	-	5	V
I_C	集电极电流 (DC)	注1 注2	-	0.9 1	A
I_{CM}	峰值集电极电流	$T = 1 \text{ ms}$ 或限制T (下最大)	-	2	A
I_B	基极电流 (DC) 的		-	300	mA
I_{BM}	峰值电流基地	$t_b = 300 \mu\text{s}$; $\delta = 0.02$	-	1	A
P _{合计}	总功耗	$T_{AMB} = 25 \text{ }^\circ\text{C}$; 注1	-	270	mW
		$T_{AMB} = 25 \text{ }^\circ\text{C}$; 注2	-	400	mW
		$T_{AMB} = 25 \text{ }^\circ\text{C}$; 注1和3	-	1.25	W
$T_{存储}$	储存温度		-65	+150	$^\circ\text{C}$
T_j	结温		-	150	$^\circ\text{C}$
T_{AMB}	工作环境温度		-65	+150	$^\circ\text{C}$

钉扎

针	描述
1	BASE
2	辐射源
3	集热器





外形尺寸 (mm最小值尺寸)

单位	A	A ₁ 马克斯	b ₁	o	D	E	e	e ₁	H _p	L ₁	Q	v	w
mm	1.1 0.9	0.1	0.45 0.38	0.15 0.09	3.0 2.8	1.4 1.2	1.9	0.95	2.5 2.1	0.45 0.15	0.55 0.45	0.2	0.1